

InGaAs фотодетекторный чип 1740 нм, 500 мкм — техническое описание

P/N : WIR3-500

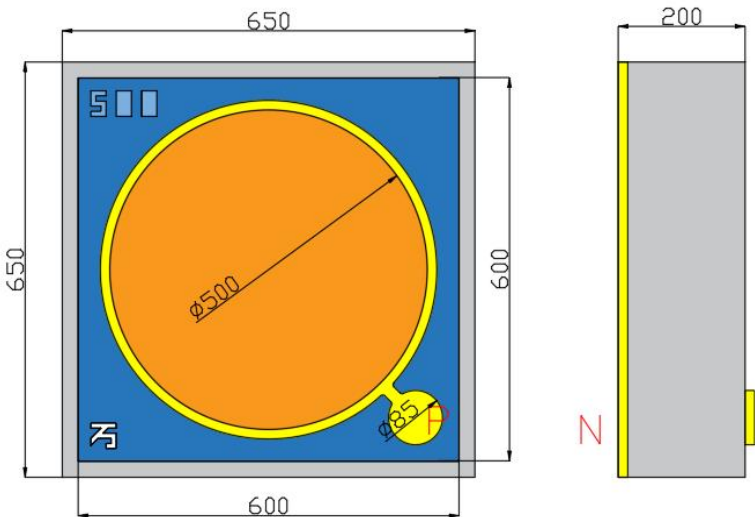
Особенности

Высокая чувствительность; низкий темновой ток; спектральная чувствительность 900–1740 нм

Структура

InGaAs/InP PIN-чип. Р-электрод (анод): золото.

N-электрод (катод): золото.



ГАБАРИТЫ

| Габариты                   | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|----------------------------|------|------|-------|----------|
| Активная область           | -    | 500  | -     | мкм      |
| Ширина чипа                | -    | 650  | -     | мкм      |
| Длина чипа                 | -    | 650  | -     | мкм      |
| Высота чипа                | 180  | 200  | 220   | мкм      |
| Размер контактной площадки | 80   | 85   | 90    | мкм      |

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

| Параметр                   | Обозначение | Условия измерения | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|----------------------------|-------------|-------------------|------|------|-------|----------|
| Темновой ток               | Id          | Vr=-5V            | -    | 0.2  | 1     | нА       |
| Емкость                    | Cp          | Vr=-5V            | -    | 15   | 25    | пФ       |
| Чувствительность           | R           | @1654 nm          | 0.9  | 1    | -     | А/Вт     |
| Рабочий диапазон длин волн | λ           |                   | 900  | 1650 | 1740  | нм       |

Примечание: ESD (HBM) > 800 В

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Параметр             | Значение             |
|----------------------|----------------------|
| Рабочая температура  | от -40 °C до +85 °C  |
| Температура хранения | от -55 °C до +125 °C |
| Прямой ток           | 10 мА                |